

а 2008 0235

Изобретение относится к области планарной технологии получения полупроводниковых слоев типа A^4B^6 , в частности к способу получения подложки BaF_2 с совершенной поверхностью.

Способ включает скалывание или резку исходной подложки вдоль выбранных кристаллографических направлений, химико-механическую полировку поверхности, вакуумный отжиг подложки при температуре $973^\circ K$, в течение 30 мин, затем нанесение дополнительного слоя BaF_2 в сверхвысоком вакууме при температуре подложки $1023^\circ K$ в течение 3...5 мин, с непрерывным контролем качества поверхности методом дифракции быстрых электронов.

П. формулы: 1

Фиг.: 3